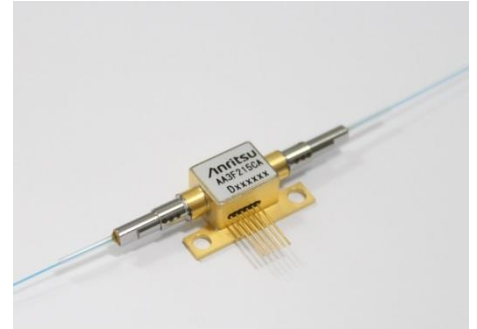


# 1.3 $\mu$ m SOA モジュール AA3F215CA

AA3F215CA はアイソレータと TEC を内蔵した高利得、低偏波依存利得の 1.3 $\mu$ m 帯半導体光増幅器 (SOA (Semiconductor Optical Amplifier)) モジュールです。

## 特長

- ・利得:  $\geq 15$ dB
- ・偏波依存利得(PDG):  $\leq 1.5$ dB
- ・アイソレータ内蔵 (入力側)
- ・低消費電力: 1.0W typ. ( $T_C=75^\circ\text{C}$ )



## 用途

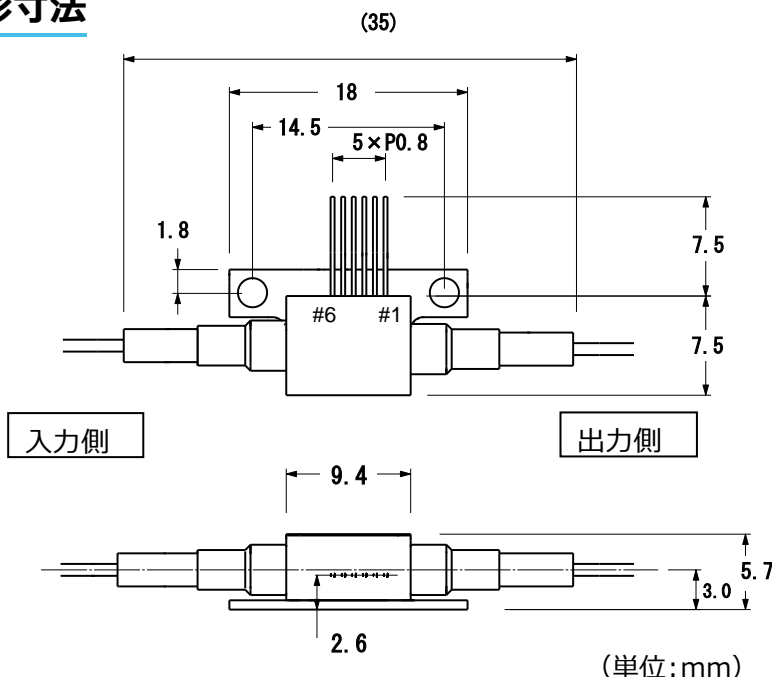
- ・100GBASE-ER4 CFP/CFP2 transceiver
- ・Preamplifier

## 絶対最大定格 ( $T_{SOA}=25^\circ\text{C}$ )

項目	記号	定格	単位
SOA 順電流	$I_F$	150	mA
SOA 逆電圧	$V_R$	2	V
動作ケース範囲	$T_C$	-5 to +75	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-40 to +85	$^\circ\text{C}$
クーラ電流	$I_C$	1.0	A
クーラ電圧	$V_C$	2.5	V

\*絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。

## 外形寸法



## 端子接続

No.	FUNCTION
1	クーラカソード
2	クーラアノード
3	サーミスタ
4	サーミスタ
5	SOA カソード
6	SOA アノード

ファイバ特性	
ファイバ種	SMF
ファイバ径	$\Phi 0.25$
最小曲げ半径	7.5mm
ファイバ長	1,000mm
コネクタ (両端)	LC コネクタ

## 光学的・電気的特性 (T<sub>SOA</sub>=25°C, T<sub>C</sub>=25°C)

項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
光学利得	G	I <sub>F</sub> =120mA, *1, *2, *3	15			dB
偏波依存利得	PDG	I <sub>F</sub> =120mA, *1, *2, *3			1.5	dB
順電流	I <sub>F</sub>		100		150	mA
順電圧	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =120mA			2.0	V
波長帯域	λ	I <sub>F</sub> =120mA	1294		1311	nm
飽和出力	P <sub>S</sub>	I <sub>F</sub> =120mA, *4		7		dBm
雑音指数	NF	I <sub>F</sub> =120mA, *1, *2, *3, *5		7		dB
クーラ電流	I <sub>C</sub>	G=(BOL), T <sub>C</sub> =75°C			0.6	A
クーラ電圧	V <sub>C</sub>	G=(BOL), T <sub>C</sub> =75°C			2.2	V
サーミスタ抵抗	R <sub>th</sub>	T <sub>SOA</sub> =25°C, B=3435±105K	9.5	10	10.5	kΩ

\*1 : 入力光条件: CW

\*2 : 下記4波長帯域が入力光として使われており、特性は各波長帯域毎に測定されています。

入力光の波長帯域は下記の通り

λ<sub>0</sub> : 1294.5~1296.6nm    λ<sub>2</sub> : 1303.5~1305.7nm

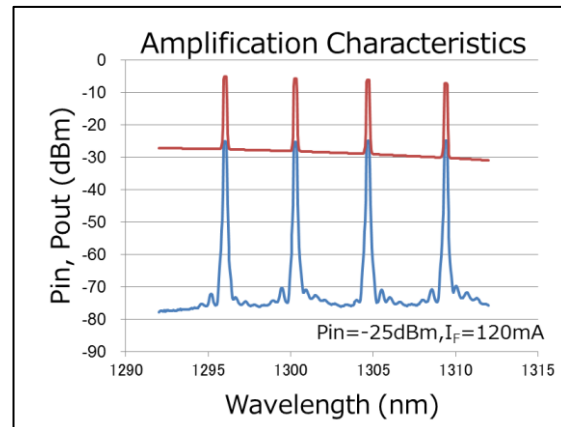
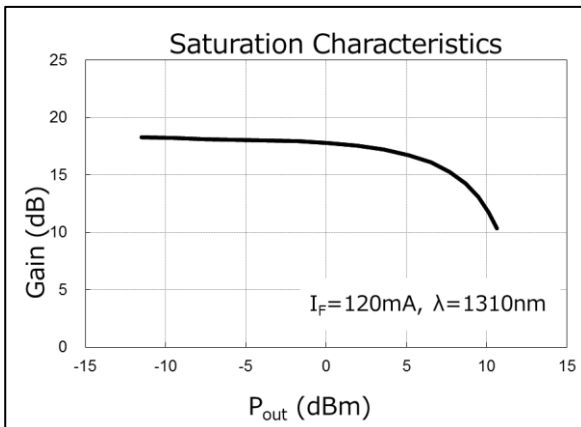
λ<sub>1</sub> : 1299.0~1301.1nm    λ<sub>3</sub> : 1308.0~1310.2nm

\*3 : 入力光レベル (Pin) = -25dBm

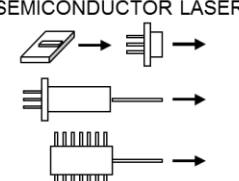
\*4 : 飽和出力は1波長(λ=1310nm)を使用し測定されています。

\*5 : 偏波コントロールなし。

## 代表的特性




SEMICONDUCTOR LASER



AVOID EXPOSURE  
Invisible laser radiation is emitted from this aperture

Caution – use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.  
This Product Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11  
Manufactured Anritsu Corp. 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan



INVISIBLE LASER RADIATION  
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

OUTPUT POWER 15mW  
WAVELENGTH 1.10 to 1.59 μm  
CLASS III b LASER PRODUCT

**ATTENTION**

OBSERVE PRECAUTIONS  
FOR HANDLING  
ELECTROSTATIC  
SENSITIVE DEVICES

CAUTION : Handle the fiber of the enclosed device(s) with extreme care ; glass fiber is subject to breakage if mishandled and permanent damage to the device may result. Do not pull the device by the fiber or protective sleeve.  
Do not coil the fiber into a loop of less than 75mm in diameter.

## アンリツ株式会社

アンリツ株式会社 デバイス営業部

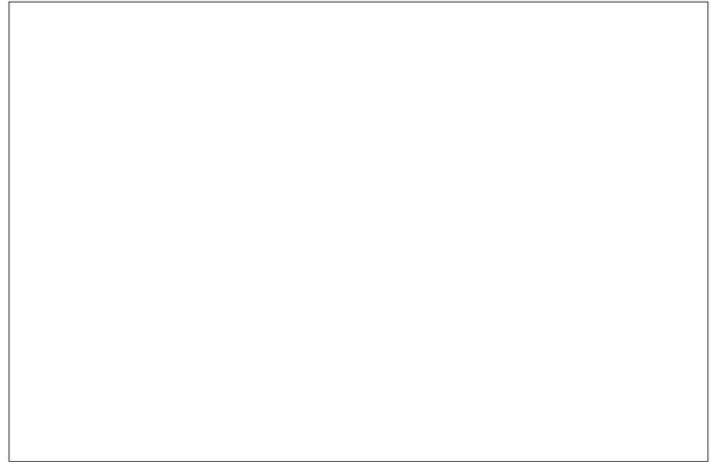
アンリツデバイス株式会社 マーケティング部

〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5

TEL 046-296-1228 FAX 046-296-1254

URL:<http://www.anritsu.com/anritsu-devices>

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。